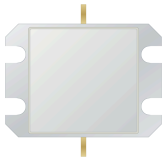
8500–9600 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 51 dBm (標準値)

LCT-8500-9600-PS51T · 8500–9600 MHz · GaN 内部整合型パワートランジスタ.

RF 電気特性表の規定値: PSAT 51 dBm (標準値); 電力利得 9 dB (標準値); PAE 38 % (標準値). RF 測定条件: Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm.



CMW025B

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

Vg: C = 10 µF

RF 特性

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	8500	-	9600	MHz
飽和出力電力	-	50	51	-	dBm
電力利得	-	8	9	-	dB
電力付加効率	-	-	38	-	%
電力利得平坦度	-	-	-	±0.8	dB

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン動作電圧	-	-	-	-	28	V
ゲート動作電圧	-	-	-	-	-3	V

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	-	-5	-	-	V
保存温度	-	-65	-	150	°C
最大入力電力	-	-	-	45	dBm
最大チャネル温度	-	-	-	200	°C

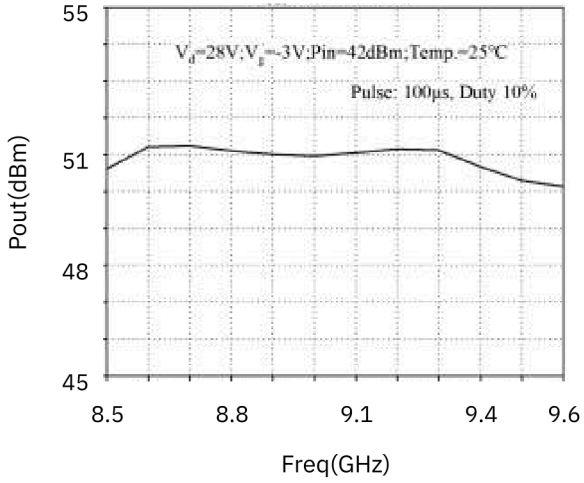
現在の発行記録 · 1.5 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.4.

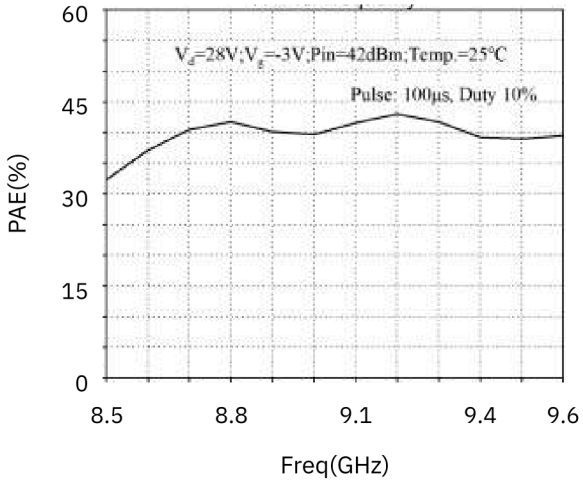
実装上の注意

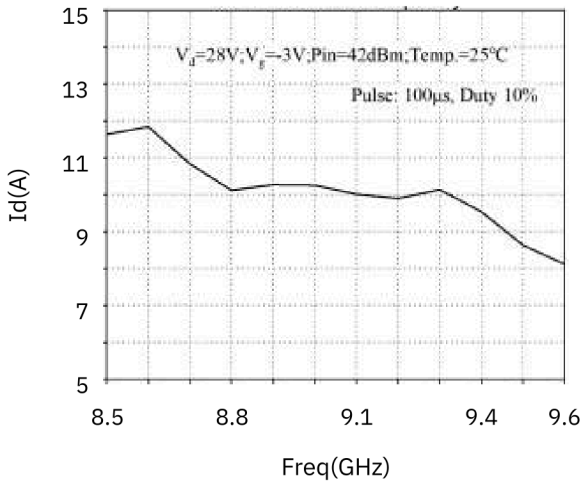
CMW025B ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 Vg: C = 10 µF G: RF入力 D: RF出力 S: ソース／グランド

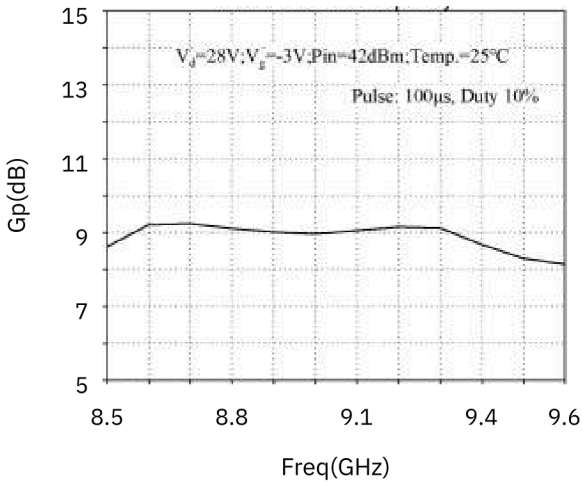
性能特性曲線

各図に記載された動作条件と併せてご確認ください。









出力電力、電力付加効率、ドレイン電流、電力利得。 Vd = 28 V; Vg = -3 V; Pin = 42 dBm; TA = 25 °C; PW = 100 µs; D = 10%.

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。